

LISTA DE LUCRĂRI

I. Lista celor 10 lucrări considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii candidatului – întreaga activitate.

1. F. Drăghici, "Amplificatoare. Noțiuni de proiectare", **Ed. Matrix Rom**, București, **2021**, ISBN 978-606-25-0665-0.
2. G. Brezeanu, G. Pristavu, **F. Draghici**, R. Pascu, F. Della Corte, S. Rascuna, "Enhanced Non-Uniformity Modeling of 4H-SiC Schottky Diode Characteristics Over Wide High Temperature and Forward Bias Ranges", **IEEE Journal of the Electron Devices Society**, Volume: 8, Pages: 1339-1344, **2020**, DOI: [10.1109/JEDS.2020.3032799](https://doi.org/10.1109/JEDS.2020.3032799), ISSN: 2168-6734, WOS:000589593200001, **Q2** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, **FI=2,555** la data publicării articolului.
3. **F. Draghici**, G. Brezeanu, G. Pristavu, R. Pascu, M. Badila, A. Pribeanu, E. Ceuca, "400°C sensor based on Ni/4H-SiC Schottky diode for reliable temperature monitoring in industrial environments", **Sensors**, **2019**, 19, 2384, [HTTPS://DOI.ORG/10.3390/S19102384](https://doi.org/10.3390/S19102384), WOS:0004711014500171, **Q1** în Domeniul Instruments & Instrumentation, **FI=3,576** la data depunerii tezei de abilitare.
4. N. Pavel, R. Chiriac, A. Birtas, **F. Draghici**, M. Dinca, "On the improvement by Laser Ignition of the Performances of a Passenger Car Gasoline Engine", **Optics Express**, Vol. 27, NO. 8, **2019**, [https://DOI.ORG/10.1364/OE.27.00A385](https://doi.org/10.1364/OE.27.00A385), WOS:000464614400013, **Q1** în Domeniul Optics, **FI=3,894** la data depunerii tezei de abilitare.
5. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, **F. Drăghici**, M. Bădilă, "Characterization of Non-Uniform Ni/4H-SiC Schottky Diodes for Improved Responsivity in High-Temperature Sensing", **Materials Science in Semiconductor Processing**, Volume 94, **2019**, pp. 64-69, ISSN 1369-8001, [https://DOI.ORG/10.1016/J.MSSP.2019.01.018](https://doi.org/10.1016/J.MSSP.2019.01.018), WOS:000458507800009, **Q1** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, **FI=3,927** la data depunerii tezei de abilitare.
6. G. Brezeanu, G. Pristavu, **F. Draghici**, M. Badila, R. Pascu, "Characterization Technique for Inhomogeneous 4H-SiC Schottky Contacts: A Practical Model for High Temperature Behavior", **Journal of Applied Physics**, Vol. 122, Article Number: 084501, **2017**, <https://doi.org/10.1063/1.4999296>, WOS:000409117200029, ISSN: 0021-8979, EISSN: 1089-7550, **Q2** în Domeniul Physics, Applied, **FI=2,546** la data depunerii tezei de abilitare.
7. G. Brezeanu, **F. Drăghici**, "Circuite Electronice Fundamentale", **Editura Niculescu**, București, **2013**, ISBN: 978-973-748-745-2.
8. G. Brezeanu, **F. Draghici**, F. Craciunoiu, C. Boianceanu, F. Bernea, F. Udrea, D. Puscasu, I. Rusu, "4H-SiC Schottky Diodes for Temperature Sensing Applications in Harsh Environments", **Materials Science Forum**, Vols. 679-680, **2011**, pp. 575-578, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.679-680.575>, ISBN: 978-3-03785-079-4, indexare ISI Web of Science, IDS: BVJ83, WOS:000291673500138, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, **FI=0,399** la data publicării.

9. F. Drăghici, F. Mitu, "Interfață analogică", *Brevet de invenție, Nr. 122980 / 28.05.2010, Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci (OSIM)*, România, Derwent Primary Accession Number: 2010-K27053 [53] în baza ISI, https://ro.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20100528&DB=ro.espacenet.com&locale=ro_RO&CC=RO&NR=122980B1&KC=B1&ND=5.

10. F. Draghici, X. Jorda, G. Brezeanu, M. Badila, J. Millan, P. Godignon, "A System for Measure Reverse Recovery Time and Stored Charge at Ultrafast Power Diodes", in *Proc. of The 24th IEEE International Semiconductor Conference*, 9-13 Oct., 2001, Sinaia, Romania, pp. 473 – 476, ISBN: 0-7803-6666-2, IEEE Catalog Number:01TH8547, indexare ISI Web of Science, IDS: BU24V, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967508](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967508), WOS:000175459600100, FI=0,25.

II. TEZA DE DOCTORAT (T)

T1 F. Drăghici, "Caracterizarea și testarea dispozitivelor de putere și temperaturi înalte pe Carbură de Siliciu", Biblioteca centrală a Universității Politehnica din București, 2004, conducător științific, Prof. dr. ing. Gheorghe Brezeanu.

III. CĂRȚI PUBLICATE (C)

Ca – Cărți/cursuri (manuale) pentru uzul studenților, publicate în edituri recunoscute

Ca.1 F. Drăghici, I. Rusu, L. Teodorescu, "Circuite Electronice - Îndrumar de Laborator", Editura Hamangiu, București, 2016, ISBN 978-606-27-0397-4.

Ca.2 I. Rusu, F. Babarada, F. Drăghici, "Dispozitive Electronice - Îndrumar de laborator", Editura Rosetti Educațional, 2011, ISBN 978-973-7881-71-7.

Cb – Cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute (autor, coautor, editor)

Cb.1 F. Drăghici, "Amplificatoare. Noțiuni de proiectare", Ed. Matrix Rom, București, 2021, ISBN 978-606-25-0665-0.

Cb.2 G. Brezeanu, F. Drăghici, F. Mitu, G. Dilimoț, "Circuite Electronice Fundamentale - Probleme", Editia a III-a, revizuită, Ed. Rosetti International, București, 2014, ISBN 978-973-8720-24-4.

Cb.3 G. Brezeanu, F. Drăghici, "Circuite electronice Fundamentale", Editura Niculescu, București, 2013, ISBN 978-973-748-745-2.

Cb.4 G. Brezeanu, F. Drăghici, F. Mitu, G. Dilimoț, "Dispozitive electronice - probleme", Editura Rosetti Educațional, București, ediția a IV-a, revizuită, 2009, ISBN 978-973-7881-57-1.

Cb.5 G. Brezeanu, F. Drăghici, F. Mitu, G. Dilimoț, "Circuite electronice fundamentale - probleme", Editura Rosetti Educațional, București, ediția a II-a, 2008, ISBN 978-973-7881-39-7.

Cb.6 G. Brezeanu, G. Dilimoț, F. Mitu, F. Drăghici, "Probleme de Dispozitive și Circuite Electronice", Editura IT GRUP, București, ediția a III-a, 2006, ISBN 973-85715-2-9.

Cb.7 G. Brezeanu, F. Drăghici, F. Mitu, G. Dilimoț, "Circuite electronice fundamentale - probleme", Editura ALL BECK, București, ediția I, 2005, ISBN 973-655-758-8.

Cb.8 G. Brezeanu, G. Dilimoț, F. Mitu, F. Drăghici, "Probleme de Dispozitive și Circuite Electronice", Editura IT GRUP, București, ediția a II-a, 2004, ISBN 973-85715-2-9.

Cb.9 G. Brezeanu, G. Dilimoț, F. Mitu, F. Drăghici, "Probleme de Dispozitive și Circuite Electronice", Editura IT GRUP, București, ediția I, 2001, ISBN 973-99959-6-9.

IV. ALTE MATERIALE PUBLICATE (I, D)

D - Alte lucrări publicate: capitole publicate în volume colective, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator funcționale etc.

D.1 Tema Post-Doctorală POSDRU/89/1.5/S/63700: **Florin Drăghici**, "*Senzori de temperatură bazați pe diode Schottky realizate pe Carbură de Siliciu (SiC) pentru aplicații în industria cimentului*", București, Martie 2013, raportările au fost publicate electronic pe web, în baza de date a IMT-București: <https://mnt-postdoc.imt.ro/>.

V. ARTICOLE / STUDII IN EXTENSO PUBLICATE (R, V)

Ris – Reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute (cotate/indexate ISI Thomson Reuters, sau indexate în alte Baze de Date Internaționale – BDI specifice domeniului, care fac un proces de selecție a revistelor pe baza unor criterii de performanță).

Ris.1 G.-C Ilie (Chiranu), C. Tudoran, O. Neagoe, **F. Draghici**, G. Brezeanu, "*Nonvolatile Analog Switch for Low-Voltage Applications*", *Electronics* 2021, 10(6), 736; <https://doi.org/10.3390/electronics10060736>, <https://doi.org/10.3390/electronics10060736>, WOS:000634338200001, **Q2** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, **FI=2,412** la data publicării.

Ris.2 R. Pascu, G. Pristavu, G. Brezeanu, **F. Draghici**, P. Godignon, C. Romanitan, M. Serbanescu, A. Tulbure, "*60–700K CTAT and PTAT Temperature Sensors with 4H-SiC Schottky Diodes*", *Sensors*, 2021, 21(3), 942; pp. 1–15, publicare online, <https://doi.org/10.3390/s21030942>, eISSN: 1424-8220, <https://doi.org/10.3390/s21030942>, WOS:000615521900001, **Q1** în Domeniul Instruments & Instrumentation, **FI=3,576** la data depunerii tezei de abilitare.

Ris.3 M. Boncu, C. Botezatu, **F. Draghici**, "*An algorithm-based method for accurate compensation of bandgap references over temperature*", *Romanian Journal Of Information Science And Technology*, Volume 24, Number 2, 2021, pp. 143–160, <https://www.romjist.ro/full-texts/paper685.pdf>, WOS:000668010700002, **Q4** în Domeniul Instruments & Instrumentation, **FI=0,643** la data depunerii tezei de abilitare.

Ris.4 G. Brezeanu, G. Pristavu, **F. Draghici**, R. Pascu, F. Della Corte, S. Rascuna, "*Enhanced Non-Uniformity Modeling of 4H-SiC Schottky Diode Characteristics Over Wide High Temperature and Forward Bias Ranges*", *IEEE Journal Of The Electron Devices Society*, Volume: 8, Pages: 1339-1344, 2020, DOI: [10.1109/JEDS.2020.3032799](https://doi.org/10.1109/JEDS.2020.3032799), ISSN: 2168-6734, WOS:000589593200001, **Q2** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, **FI=2,555** la data publicării.

Ris.5 **F. Draghici**, G. Brezeanu, G. Pristavu, R. Pascu, M. Badila, A. Pribeanu, E. Ceuca, "*400°C Sensor Based on Ni/4H-SiC Schottky Diode for Reliable Temperature Monitoring in Industrial Environments*". *Sensors*, 2019, 19, 2384, <https://doi.org/10.3390/s19102384>, WOS:0004711014500171, **Q1** în Domeniul Instruments & Instrumentation, **FI=3,576** la data depunerii tezei de abilitare.

Ris.6 N. Pavel, R. Chiriac, A. Birtas, **F. Draghici**, M. Dinca, "*On the improvement by laser ignition of the performances of a passenger car gasoline engine*", *Optics Express*, Vol. 27, No. 8, 2019, <https://doi.org/10.1364/OE.27.00A385>, WOS:000464614400013, **Q1** în Domeniul Optics, **FI=3,894** la data depunerii tezei de abilitare.

Ris.7 G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, **F. Drăghici**, M. Bădilă, "Characterization of non-uniform Ni/4H-SiC Schottky diodes for improved responsivity in high-temperature sensing", **Materials Science in Semiconductor Processing**, Volume 94, **2019**, Pages 64-69, ISSN 1369-8001, <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2019.01.018>, WOS:000458507800009, **Q1** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, **FI=3,927** la data depunerii tezei de abilitare.

Ris.8 G. Brezeanu, G. Pristavu, **F. Draghici**, M. Badila, R. Pascu, "Characterization technique for inhomogeneous 4H-SiC Schottky contacts: A practical model for high temperature behavior", **Journal of Applied Physics**, Vol. 122, Article number: 08450, **2017**, <https://doi.org/10.1063/1.4999296>, ISSN: 0021-8979, eISSN: 1089-7550, WOS:000409117200029, **Q2** în Domeniul Physics, Applied, **FI=2,546** la data depunerii tezei de abilitare.

Ris.9 A. Enache, I. Rusu, **F. Draghici**, G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Enache, "High Accuracy Amperometric Sense and Control Circuit for Three-electrode Biosensors", **Romanian Journal Of Information Science And Technology**, Volume: 19, Issue: 3, Pages: 295-308, **2016**, <https://www.romjist.ro/content/pdf/enache.pdf>, WOS:000405151400008, **Q4** în Domeniul Instruments & Instrumentation, **FI=0,643** la data depunerii tezei de abilitare.

Ris.10 B. Ofrim, G. Brezeanu, **F. Draghici**, I. Rusu, "High Temperature Hydrogen Sensor based on Silicon Carbide (SiC) MOS Capacitor Structure", **Materials Science Forum**, cu titlul Silicon Carbide and Related Materials 2013 PTS 1 and 2, Vols. 778-780, **2014**, pp. 1054-1057, ISSN: 0255-5476, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.778-780.1054>, WOS:000336634100251, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, **FI=0,399** la data publicării.

Ris.11 G. Brezeanu, **F. Draghici**, M. Badila, F. Craciunoiu, G. Pristavu, R. Pascu, F. Bernea, "Two Packaging Solutions for High Temperature SiC Diode Sensors", **Materials Science Forum**, cu titlul Silicon Carbide and Related Materials 2013 PTS 1 and 2, Vols. 778-780, **2014**, pp. 1063-1066, ISSN: 0255-5476, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.778-780.1063>, WOS:000336634100253, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, **FI=0,399** la data publicării.

Ris.12 **F. Draghici**, G. Brezeanu, I. Rusu, F. Bernea, P. Godignon, "High Temperature SiC Sensor With an Isolated Package", **Materials Science Forum**, **2013**, with title Silicon Carbide and Related Materials 2012, vols. 740-742, 2013, ISBN: 978-3-03785-419-8, IDS: BFG56, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.740-742.1002>, WOS:000319785500239, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, **FI=0,399** la data publicării.

Ris.13 L. Teodorescu, A. S. Gheorghe, **F. Draghici**, "Digital signage equipment for gas station pumps application", **U.P.B. Sci. Bull., Series C**, Vol. 75, Iss. 4, **2013**, ISSN 2286 – 3540, pp. 57-68, B+, https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full255_124795.pdf, SCOPUS.

Ris.14 G. Brezeanu, **F. Draghici**, M. Badila, I. Rusu, F. Bernea, P. Godignon, "A Fully Electrically Isolated Package for High Temperature SiC Sensors", **Materials Science Forum**, with title Silicon Carbide and Related Materials 2011, Vols. 717-720, **2012**, 925-928, ISBN: 978-3-03785-419-8, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.717-720.925>, WOS:000309431000220, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, **FI=0,399** la data publicării.

Ris.15 G. Brezeanu, **F. Draghici**, F. Craciunoiu, C. Boianceanu, F. Bernea, F. Udrea, D. Puscasu, I. Rusu, "4H-SiC Schottky Diodes for Temperature Sensing Applications in Harsh Environments", **Materials Science Forum**, with title Silicon Carbide and Related Materials 2010, Vols. 679-680, **2011**, pp. 575-578, 10.4028/Www.Scientific.Net/Msf.679-680.575, ISBN: 978-3-03785-079-4, IDS: BVJ83, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.679-680.575>, WOS:000291673500138, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, **FI=0,399** la data publicării.

Ris.16 G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, **F. Draghici**, R. Pascu, F. Craciunoiu, I. Rusu, A. Pribeanu, "*High Temperature Behavior Prediction Techniques for Non-Uniform Ni/SiC Schottky Diodes*", **Materials Science Forum**, Vol. 924, pp. 967-970, **2018**, Trans Tech Publication, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.924.967>, [Scopus, INSPEC].

Ris.17 G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, **F. Draghici**, R. Pascu, F. Craciunoiu, I. Rusu, A. Pribeanu, "*Barrier Stability of Pt/4H-SiC Schottky Diodes Used for High Temperature Sensing*", **Materials Science Forum**, Vol. 897, cu titlul - Silicon Carbide and Related Materials 2016, pp. 606-609, May **2017**, ISSN: 02555476, ISBN: 978-303571043-4, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.897.606>, [Scopus, INSPEC].

Ris.18 G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, **F. Draghici**, R. Pascu, F. Craciunoiu, "*An Investigation of SiC Schottky Contact Barrier Inhomogeneity for Temperature Sensing Applications*", **Materials Science Forum**, Vol. 858, pp. 577-581, **2016**, Trans Tech Publication, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.858.577>, [Scopus, INSPEC].

Ris.19 R. Pascu, G. Pristavu, G. Brezeanu, **F. Draghici**, M. Badila, I. Rusu, F. Craciunoiu, "*Electrical Characterization of Ni-Silicide Schottky Contacts on SiC for High Performance Temperature Sensor*", **Materials Science Forum**, Vols. 821-823, pp. 436-439, **2015**, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.821-823.436>, [Scopus, INSPEC].

Ris.20 G. Brezeanu, **F. Draghici**, C. Boianceanu, "*SiC photodetectors with high UV selectivity and sensitivity*", **Romanian Journal of Physics**, vol. 48, nr.1-4, **2003**, pp.171-84, ISSN 1221-146X, indexat in Science Citation Expanded (SciSearch®) and Journal Citation Reports/Science Edition, JCR 2012, FI (2012)=0.526, https://rjp.nipne.ro/2003_48_1-4.html, [Scopus, INSPEC].

Rno - Alte reviste de specialitate de circulație națională

Rno.1 **F. Draghici**, B. Ofrim, G. Brezeanu, F. Mitu, F. Bernea, "*High Temperature Automatic Characterization System For Semiconductor Devices*", **Annals of the Academy of Romanian Scientists**, Vol.4, **2011**, pp. 51-64, ISSN 2066 - 8562, http://www.aos.ro/site_mod/Publicatii/2011/AnaleINFOnr2pe2011.pdf, și Indexare Google Scholar,.

Vis_ISI – Volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, organizate în țară și străinătate, indexate ISI Thomson Reuters

Vis_isi.1 M. Gheorghe, P. Mugur Svasta, S. Gheorghe, C. Ionescu, **F. Draghici**, "*Organic Electrical Passive Components Based on Polyaniline*", **2020 IEEE 8th Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC)**, 15-18 Sept. **2020**, Tønsberg, Vestfold, Norway, Electronic ISBN:978-1-7281-6293-5, Print on Demand (PoD) ISBN:978-1-7281-6294-2, DOI: [10.1109/ESTC48849.2020.9229672](https://doi.org/10.1109/ESTC48849.2020.9229672), WOS: 000631824100013.

Vis_isi.2 M. Boncu, C. Botezatu, **F. Draghici**, "*A precise method for compensating bandgap references over temperature*", in **Proceedings of the 2020 International Semiconductor Conference (CAS)**, 7-9 Oct. **2020**, Sinaia, Romania, pp. 245-248, eISBN:978-1-7281-1073-8, Print on Demand (PoD) ISBN:978-1-7281-1074-5, DOI: [10.1109/CAS50358.2020.9268045](https://doi.org/10.1109/CAS50358.2020.9268045), WOS:000637264600055.

Vis_isi.3 A. Enache, **F. Drăghici**, G. Pristavu, G. Brezeanu, "*Voltage Controlled Oscillator for Small-Signal Capacitance Sensing*", in **Proceedings of the 2019 International Semiconductor Conference (CAS)**, Sinaia, Romania, 9-11 Oct. **2019**, DOI: [10.1109/SMICND.2019.8923728](https://doi.org/10.1109/SMICND.2019.8923728), WOS:000514295300068.

Vis_isi.4 A. Birtas, N. Boicea, G. Croitoru, M. Dinca, N. Pavel, **F. Draghici**, R. Chiriac, "*On the possibility to improve petrol engine operation by laser ignition*", **Energy Procedia**, Vol. 157, Pp. 1022-1028, Elsevier, **2019**, ISSN: 1876-6102, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.269>, WOS:000470998600112.

- Vis_isi.5** N. Pavel, R. Chiriac, A. Birtas, N. Boicea, **F. Draghici**, G. Croitoru, M. Dinca, "*Lean-Mixture Operation of a Passenger Car Gasoline Engine Ignited by Passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+: YAG Laser Spark Plugs*", in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2019), paper cm_p_13., ISBN:978-1-7281-0469-0, DOI: [10.1109/CLEOE-EQEC.2019.8872741](https://doi.org/10.1109/CLEOE-EQEC.2019.8872741), WOS:000630002701062.
- Vis_isi.6** R.V. Petrica, M.D. Dobre, P. Coll, **F. Draghici**, G. Brezeanu, "*Comparison of Level Shifter Architectures: Application to I/O Cell*", in **Proc. of the 2018 International Semiconductor Conference (CAS)**, Sinaia, Romania, pp. 209-212, 2018, IEEE., DOI: [10.1109/SMICND.2018.8539796](https://doi.org/10.1109/SMICND.2018.8539796), WOS:000514386700041
- Vis_isi.7** R. Pascu, M. Danila, P. Varasteanu, M. Kusko, G. Pristavu, G. Brezeanu, **F. Draghici**, "*Improved Ti/Pt/Au-n-Type Si Contacts by Post-Metallization Annealing in Nitrogen Atmosphere*", in **Proc. of the 2018 International Semiconductor Conference (CAS)**, Sinaia, Romania, pp. 307-310, 2018, IEEE, DOI: [10.1109/SMICND.2018.8539839](https://doi.org/10.1109/SMICND.2018.8539839), WOS:000514386700064.
- Vis_isi.8** A. Birtas, N. Boicea, **F. Draghici**, R. Chiriac, G. Croitoru, M. Dinca T. Dascalu, N. Pavel, "*On the assessment of performance and emissions characteristics of a SI engine provided with a laser ignition system*", in **(CAR2017) Book Series: IOP Conference Series- Materials Science and Engineering**, Volume: 252, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI: <http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/252/1/012071>, WOS:000419817200071.
- Vis_isi.9** A. Enache, I. Rusu, B. Bucur, **F. Drăghici**, G. Pristavu, M.P. Bucur, F. Enache, G. Brezeanu, "*Experimental Characterization of a High Accuracy Amperometric Sense and Control Circuit for Three-Electrode Biosensors*", in **Proc. of the 40th International Semiconductor Conference**, 11-14 Oct. 2017, Sinaia, Romania, pp.179-182, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-5090-3985-2, DOI: [10.1109/SMICND.2017.8101193](https://doi.org/10.1109/SMICND.2017.8101193), WOS:000425844500037.
- Vis_isi.10** G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, **F. Draghici**, M. Badila, I. Rusu, "*Study on thermal sensitivity of highly inhomogeneous Ni/4H-SiC Schottky diode over a wide temperature range*", in **Proc. of the 40th International Semiconductor Conference**, 11-14 Oct. 2017, Sinaia, Romania, pp. 255-256, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-5090-3985-2, DOI: [10.1109/SMICND.2017.8101216](https://doi.org/10.1109/SMICND.2017.8101216), WOS:000425844500056.
- Vis_isi.11** A. Enache, I. Rusu, **F. Drăghici**, Gh. Brezeanu, Gh. Pristavu, F. Enache, "*Smart Sensor For Chemical Compounds Concentration*", in **Proc. of the 39th International Semiconductor Conference**, 10-12 Oct. 2016, Sinaia, Romania, pp.201-204, ISBN: 9781509012077, ISSN: 1545827X, DOI: [10.1109/SMICND.2016.7783086](https://doi.org/10.1109/SMICND.2016.7783086), WOS:000391323300041.
- Vis_isi.12** L. Teodorescu, **F. Drăghici**, I. Rusu, G. Brezeanu, "*On Wafer High Temperature Characterization System*", in **Proc. of the 8th International Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies (ATOMN)**, SEP 25-28, 2016, Constanta, Romania, pp. 8, ISBN: 9781510604247; 9781510604254, ISSN: 0277786X, <https://doi.org/10.1117/12.2247062>, WOS:000391359600006.
- Vis_isi.13** C. Ionescu, **F. Drăghici**, D. Bonfert, "*A SPICE model for electroluminescent foils*", in **Proc. of the 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)**, 6-10 May 2015, Eger, Hungary, pp: 526 - 531, ISSN: 2161-2528, DOI: [10.1109/ISSE.2015.7248057](https://doi.org/10.1109/ISSE.2015.7248057), WOS:000374113000105.
- Vis_isi.14** G. Brezeanu, M. Badila, **F. Draghici**, R. Pascu, G. Pristavu, F. Craciunoiu, I. Rusu, "*High temperature sensors based on silicon carbide (SiC) devices*", in **Proc. of the 38th International Semiconductor Conference**, 12-14 Oct. 2015, Sinaia, Romania, pp. 3-10, ISBN: 978-1-4799-8862-4, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2015.7355147](https://doi.org/10.1109/SMICND.2015.7355147), WOS:000380566400001.

- Vis_isi.15** G. Pristavu, A. Vasilica, V. Anghel, R. Pascu, G. Brezeanu, **F. Draghici**, "*High voltage freewheeling diodes in an extended capability LED driving application*", in **Proc. of the 38th International Semiconductor Conference**, 12-14 Oct. **2015**, Sinaia, Romania, pp.175 - 178, ISBN: 978-1-4799-8862-4, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2015.7355199](https://doi.org/10.1109/SMICND.2015.7355199), WOS:000380566400033.
- Vis_isi.16** N. Bădălan, P. Svasta, **F. Drăghici**, "*Constant current versus pulse current for power supplies on high power LED*", in **Proc. of the 21st International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)**, **2015 IEEE**, 22-25 Oct. **2015**, Brasov, Romania, pp. 263 - 266, DOI: [10.1109/SIITME.2015.7342337](https://doi.org/10.1109/SIITME.2015.7342337), WOS:000377765500049.
- Vis_isi.17** R. Pascu, G. Pristavu, M. Badila, G. Brezeanu, **F. Draghici**, F. Craciunoiu, "*Temperature Behavior of 4H- SiC MOS Capacitor Used as a Gas Sensor*", in **Proc. of the 37th International Semiconductor Conference (CAS)**, 13-15 Oct. **2014**, Sinaia, Romania, pp. 185-188 (ISI), ISBN: 978-1-4799-3916-9, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2014.6966430](https://doi.org/10.1109/SMICND.2014.6966430), WOS:000380488300036.
- Vis_isi.18** L. Teodorescu, A. Gheorghe, **F. Draghici**, G. Brezeanu, I. Rusu, "*Power Supply Architecture for High Temperature Chuck Systems*", in **Proc. of the 37th International Semiconductor Conference**, 13-15 Oct. **2014**, Sinaia, Romania, pp.193-196 (ISI), ISBN: 978-1-4799-3916-9, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2014.6966432](https://doi.org/10.1109/SMICND.2014.6966432), WOS:000380488300038.
- Vis_isi.19** G. Pristavu, **F. Draghici**, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Craciunoiu, "*High Temperature SiC-Sensors*", (Conference Paper) **IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014 - Conference Proceedings**, pp. 329-332, Bucuresti, Romania, 23 - 26 October **2014**, ISBN: 978-1-4799-6962-3, DOI: [10.1109/SIITME.2014.6967024](https://doi.org/10.1109/SIITME.2014.6967024), WOS:000358258300061.
- Vis_isi.20** **F. Draghici**, M. Pantazica, N. D. Codreanu, P. Svasta, "*Hands on Project Key Issue in the Education of Future Electronic Engineers*", **Proceedings of the 37th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) - Advances in Electronic System Integrations, Book Series: International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE**, pp. 470-475, **2014**, ISBN: 978-1-4799-4455-2, ISSN: 2161-2528, DOI: [10.1109/ISSE.2014.6887646](https://doi.org/10.1109/ISSE.2014.6887646), WOS:000346580500093.
- Vis_isi.21** G. Pristavu, G. Brezeanu, **F. Draghici**, "*Two parameter extraction solutions for high temperature SiC Schottky diodes - Converging to reality*", in **Proceedings of the IEEE 19th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)**, Oct. 24-27, **2013**, pp:181-184, ISBN:978-1-4799-1555-2, DOI: [10.1109/SIITME.2013.6743669](https://doi.org/10.1109/SIITME.2013.6743669), WOS:000347562900030.
- Vis_isi.22** **F. Draghici**, M. Badila, G. Brezeanu, G. Pristavu, I. Rusu, F. Craciunoiu, R. Pascu, "*4H-SiC Schottky Contact Improvement for Temperature Sensor Applications*", in **Proc. of the 36th International Semiconductor Conference (CAS)**, 14-16 oct. **2013**, Sinaia, Romania, Vol. 2, ISBN:978-1-4673-5672-5; 978-1-4673-5670-1, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2013.6688645](https://doi.org/10.1109/SMICND.2013.6688645), WOS:000330180800033.
- Vis_isi.23** A. B. Nae, G. Brezeanu, **F. Draghici**, "*CMOS Current Reference With Improved Temperature Compensation*", in **Proc. of the 36th International Semiconductor Conference (CAS)**, Oct. 14-16 **2013**, Sinaia, Romania, Vol.2, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-4673-5672-5; 978-1-4673-5670-1, DOI: [10.1109/SMICND.2013.6688683](https://doi.org/10.1109/SMICND.2013.6688683), WOS:000330180800059.
- Vis_isi.24** L. Teodorescu, **F. Draghici**, G. Brezeanu, I. Rusu, "*High Temperature Characterization System for Silicon Carbide Devices*", in **Proc. of the 35th IEEE International Semiconductor Conference (CAS)**, Oct. 15-17 **2012**, Sinaia, Romania, Vol. 2, IEEE Catalog Number: CFP12CAS-PRT, ISBN: 978-1-4673-0736-9, ISSN: 1545-827X, pp. 449-452, DOI: [10.1109/SMICND.2012.6400734](https://doi.org/10.1109/SMICND.2012.6400734), WOS:000314223700093.

- Vis_isi.25** R. Pascu, F. Craciunoiu, M. Kusko, **F. Draghici**, A. Dinescu, M. Danila, "*The Effect of the Post-Metallization Annealing of Ni/n-type 4H-SiC Schottky Contact*", in **Proc. of the 35th IEEE International Semiconductor Conference**, 15-17 Oct. **2012**, Sinaia, Romania, vol. 2, IEEE Catalog Number: CFP12CAS-PRT, ISBN: 978-1-4673-0736-9, ISSN: 1545-827X, pp. 457-460, DOI: [10.1109/SMICND.2012.6400732](https://doi.org/10.1109/SMICND.2012.6400732), WOS:000314223700095.
- Vis_isi.26** R. Pascu, **F. Draghici**, M. Badila, F. Craciunoiu, G. Brezeanu, A. Dinescu, I. Rusu, "*High Temperature Sensor Based on SiC Schottky Diodes with Undoped Oxide Ramp Termination*", in **Proc. of the 34th IEEE International Semiconductor Conference**, 17-19 Oct. **2011**, Sinaia, Romania, Vol. 2, pp. 379-382, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-61284-171-7, DOI: [10.1109/SMICND.2011.6095823](https://doi.org/10.1109/SMICND.2011.6095823), WOS:000320322000086.
- Vis_isi.27** **F. Draghici**, M. Badila, G. Brezeanu, I. Rusu, F. Craciunoiu, I. Enache, "*An Industrial Temperature Probe Based on SiC Diodes*", in **Proc. of the 33rd International Semiconductor Conference**, 11-13 Oct. **2010**, Sinaia, Romania, vol. 2, pp. 409-412, IEEE Catalog Number: CFP10CAS-PRT, ISBN: 978-1-4244-5971-6, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2010.5650596](https://doi.org/10.1109/SMICND.2010.5650596), WOS:000371396100084.
- Vis_isi.28** **F. Draghici**, I. Rusu, G. Brezeanu, B. Bucur, "*An Accurate Method For Measuring Very Low Frequency Biosignals*", in **Proc. of the 32nd IEEE International Semiconductor Conference**, 12-14 Oct. **2009**, Sinaia, Romania, pp. 423-426, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-4244-4413-7, DOI: [10.1109/SMICND.2009.5336688](https://doi.org/10.1109/SMICND.2009.5336688), WOS:000279558600085.
- Vis_isi.29** G. Brezeanu, A. Sevcenco, C. Boianceanu, I. Rusu, **F. Draghici**, "*A Complete Analytical Submicron MOS Transistor Drain Model for Analog Applications*", in **Proc. of the 31th IEEE International Semiconductor Conference**, 13-15 Oct. **2008**, Sinaia, Romania, pp. 309-312, ISBN: 978-1-4244-2004-9, DOI: [10.1109/SMICND.2008.4703411](https://doi.org/10.1109/SMICND.2008.4703411), WOS:000267590800063.
- Vis_isi.30** A. Sevcenco, G. Brezeanu, M. Badila, **F. Draghici**, I. Rusu, A. Visoreanu, "*Experimental Validation of a Simple Analytical Model for the Electrical Behavior of Nanoscale MOSFETs*", in **Proc. of the 30th IEEE International Semiconductor Conference**, 15-17 Oct. **2007**, Sinaia, Romania, pp. 551-554, ISBN: 978-1-4244-0847-4, DOI: [10.1109/SMICND.2007.4519783](https://doi.org/10.1109/SMICND.2007.4519783), WOS:000255865200120.
- Vis_isi.31** G. Brezeanu, A. Visoreanu, M. Brezeanu, F. Udrea, G. A. J. Amaratunga I. Enache, I. Rusu, **F. Draghici**, "*OFF- State performance of Ideal Schottky Barrier Diodes (SBD) on Diamond and Silicon Carbide*", in **Proc. of the 29th IEEE International Semiconductor Conference**, 27-29 Sept. **2006**, Sinaia, Romania, pp. 319-322, ISBN: 1-4244-0109-7, DOI: [10.1109/SMICND.2006.284008](https://doi.org/10.1109/SMICND.2006.284008), WOS:000243090700066.
- Vis_isi.32** G. Brezeanu, M. Badila, M. Brezeanu, F. Udrea, C. Boianceanu, I. Enache, **F. Draghici**, A. Visoreanu, "*Breakdown performances improvements of SiC diodes using high-k dielectrics*", in **Proc. of the 28th IEEE International Semiconductor Conference**, 2-4 Oct., **2005**, Sinaia, Romania, pp. 357-360, ISBN: 0-7803-9214-0, DOI: [10.1109/SMICND.2005.1558799](https://doi.org/10.1109/SMICND.2005.1558799), WOS:000237180300078.
- Vis_isi.33** C. Boianceanu, G. Brezeanu, F. Udrea, G. Amaratunga, M. Brezeanu, A. Mihaila, **F. Draghici**, I. Enache, A. Visoreanu, "*SiC Device Parameters Effects on the Electrical Behaviour of mCascode Switch*", in **Proc. of the 27th International Semiconductor Conference**, 4-6 Oct., **2004**, Sinaia, Romania, pp. 389-392, ISBN: 0-7803-8499-7, DOI: [10.1109/SMICND.2004.1403026](https://doi.org/10.1109/SMICND.2004.1403026), WOS:000228010700079.
- Vis_isi.34** P. Agache, C. Boianceanu, **F. Draghici**, G. Dilimot, G. Brezeanu, "*Data Acquisition and Processing for Semiconductor Devices*", in **Proc. of the 26th IEEE International Semiconductor Conference**, September 28- October 2, **2003**, Sinaia, Romania, pp. 223 - 226, ISBN: 0-7803-7821-0, DOI: [10.1109/SMICND.2003.1252422](https://doi.org/10.1109/SMICND.2003.1252422), WOS:000189468100047.

Vis_isi.35 G. Brezeanu, F.Udrea, A.Mihaila, G.Amaratunga, J. Millan, P. Godignon, M. Badila, **F. Draghici**, C. Boianceanu, M. Brezeanu, "Numerical and Analytical Study of 6H-SiC Detectors with High UV Performance", in **Proc. of the 25th IEEE International Semiconductor Conference, 2002**, Sinaia, Romania, pp. 185-188, ISBN: 0-7803-7440-1, DOI: [10.1109/SMICND.2002.1105827](https://doi.org/10.1109/SMICND.2002.1105827), WOS:000181629400039.

Vis_isi.36 **F. Draghici**, F. Mitu, G. Brezeanu, M. Badila, C. Boianceanu, P. Agache, I. Enache, "Electrical and Optical Behavior of the SiC Photodetectors", in **Proc. of the 25th IEEE International Semiconductor Conference**, 8-12 Oct., **2002**, Sinaia, Romania, pp.195 -198, ISBN: 0-7803-7440-1, DOI: [10.1109/SMICND.2002.1105829](https://doi.org/10.1109/SMICND.2002.1105829), WOS:000181629400041.

Vis_isi.37 **F. Draghici**, X. Jorda, G. Brezeanu, M. Badila, J. Millan, P. Godignon, "A System for Measure Reverse Recovery Time and Stored Charge at Ultrafast Power Diodes", in **Proc. of the 24th IEEE International Semiconductor Conference**, 9-13 Oct., **2001**, Sinaia, Romania, pp. 473 - 476, ISBN: 0-7803-6666-2, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967508](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967508), WOS:000175459600100.

Vis_isi.38 M. Badila, G. Brezeanu, V. Banu, P. Godignon, J. Millan, X. Jorda, **F. Draghici**, "SiC power Schottky diodes industrial development", in **Proc. of the 24th IEEE International Semiconductor Conference**, 9-13 Oct., **2001**, Sinaia, Romania, pp. 337 - 340, ISBN: 0-7803-6666-2, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967478](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967478), WOS:000175459600070.

Vis_isi.39 F. Mitu, **F. Draghici**, G. Dilimot, C. Amitroaie, I. Vladan, "A Characterisation Technique for High Power/Temperature Devices Using HP4275/3437 Systems", in **Proc. of the 23rd IEEE International Semiconductor Conference**, 10-14 Oct. **2000**, Sinaia, Romania, pp. 337-340, ISBN: 0-7803-5885-6, DOI: [10.1109/SMICND.2000.890251](https://doi.org/10.1109/SMICND.2000.890251), WOS:000168560900068.

Vis_isi.40 **F. Draghici**, F. Mitu, G. Dilimot, I. Enache, "Method to increase the thermal stability of the heating circuits", in **Proc. of the 21st International Semiconductor Conference**, 6-10 Oct. **1998**, Sinaia, Romania, pp. 501-504, ISBN: 0-7803-4432-4, [10.1109/SMICND.1998.733795](https://doi.org/10.1109/SMICND.1998.733795), WOS:000078772400094.

Vis_isi.41 F. Mitu, **F. Draghici**, G. Dilimot, G. Brezeanu, I. Enache, "GTO gating circuit by open cathode method", in **Proc. of the 20th International Semiconductor Conference**, 7-11 Oct. **1997**, Sinaia, Romania, pp. 123-126, ISBN: 0-7803-3804-9, DOI: [10.1109/SMICND.1997.651562](https://doi.org/10.1109/SMICND.1997.651562), WOS:000072168800020.

Vis_BDI- Volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, organizate în țară și străinătate, indexate în alte Baze de Date Internaționale - BDI specifice domeniului. Se menționează la fiecare lucrare Baza BDI.

Vis_bdi.1M. Badila, G. Brezeanu, J. P. Chante, Marie-Laure Locatelli, J. Millan, P. Godignon, P. Lungu, F. Mitu, **F. Draghici**, F. J. Campos, A.Lebedev, V. Banu, G. Banoiu, "A Technique To Avoid Micropipe Effects on 6H-SiC Power Devices", in **Proc. of the 22nd International Semiconductor Conference**, 5-9 Oct., **1999**, Sinaia, Romania, pp. 187 - 190, IEEE Catalog Number: 99TH8389, ISBN: 0-7803-513 9-8 Softbound Edition, 0-7803-5140-1 Microfiche Edition, IEEE - IEEEXplore, DOI: [10.1109/SMICND.1999.810459](https://doi.org/10.1109/SMICND.1999.810459), <http://ieeexplore.ieee.org>.

Vi - Volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, organizate în țară și străinătate

Vi.1 G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, **F. Draghici**, R. Pascu, A. Pribeanu, "Barrier stability of Pt/4H-SiC Schottky diodes used for high temperature sensing", in Proceedings **with Abstracts (two pages) of the 11th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM 2016)**, Halkidiki, Greece, 2016, <https://ecscrm2016.org/programme/>.

Vi.2 R. Pascu, G. Pristavu, G. Brezeanu, **F. Draghici**, M. Badila, F. Craciunoiu, “*Electrical characterization of Ni-silicide Schottky contacts on SiC for high performance temperature sensor*”, Proceedings with Abstracts (two pages) of the 10th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM), Grenoble, France, 21.-25 Sept. 2014.

Vi.3 B. Ofrim, G. Brezeanu, **F. Draghici**, I. Rusu, “*High Temperature Hydrogen Sensor based on Silicon Carbide (SiC) MOS Capacitor Structure*”, Proceedings with Abstracts (two pages) of the International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM2013), September 29 - October 4, 2013, Phoenix Seagaia Resort, Miyazaki, Japan, ISBN 978-4-86348-378-1, publicat ca abstract de 2 pagini in Proceedings-ul Conferintei ICSCRM2013 și selectionat pentru publicare in extenso in Materials Science Forum 2014, ISI, http://icscrm2013.org/index.php?plugin=attach&refer=program&openfile=ICSCRM2013_Technical_Program_1004Final.pdf.

Vi.4 G. Brezeanu, **F. Draghici**, C. Boianeanu, “*SiC Photodetectors with High UV Selectivity and Sensitivity*”, at The 3rd International Balkan Workshop On Applied Physics, 26-28 June, 2002, Tirgoviste, Romania, vizibil la http://www.nipne.ro/rjp/archive/contents_2003_48_1-4.pdf

Vi.5 G. Brezeanu, P. Godignon, J.Millan, F.Udrea, G.Amaratunga, M. Badila, A.Mihaila, **F. Draghici**, “*Comparison of Schottky and PN 6H-SiC Photodetectors with Excellent UV Sensitivity and Selectivity*” in Proceedings of Diamond-Like Materials, Nitrides and Silicon Carbide Conference, 12-17 Sept. 2002, Granada, Spain, <https://www.elsevier.com/events/conferences/international-conference-on-diamond-and-carbon-materials/about/previous-events>

Vn - Volumele unor manifestări științifice naționale.

Vn.1 **F. Drăghici**, M. Pantazică, P. Svasta, “*Disciplina de tip proiect din curricula academică, o foarte bună punte de legătură cu mediul industrial studiu de caz-exercițiu de creație inginerescă în structura curriculară*”, prezentare la Workshop-ul „Parteneriatul între industria electronică și mediul educațional în formarea resursei umane”, Oradea, 20 octombrie 2016. Prezentarea și lucrarea sunt disponibile pe site-ul <http://www.apte.org.ro>. lucrarea a fost publicata in proceedingul workshop-ului, pp. 33-57, variantă tipărită și publicată și în variantă electronică la http://www.apte.org.ro/media/program_workshop_siitme_2016.pdf, https://apte.org.ro/media/Prezentarea_Conf._Florin_Draghici-Facultatea_ETTI_Bucuresti.pdf

Vn.2 **F. Draghici**, I. Rusu, G. Brezeanu, M. Badila, C. Boianeanu, I. Enache, ‘*High Temperature Probe Based on SiC Schottky Diode for Hostile Environments*’, in the Book of Abstracts – Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, SATEE 2010, 09 -11 September, 2010, Alba Iulia, Romania, pp.41-42, google academic la <http://www.satee.uab.ro/uploads/SATEE2010.pdf#page=44>

Vn.3 G. Brezeanu, **F. Drăghici**, I. Rusu, D. Pușcașu, F. Bernea, “*Sondă de temperatură cu diode senzor pe SiC pentru aplicații speciale în industria cimentului*”, 2nd National Conference on Applied Sciences in Environmental and Materials Studies, Târgoviște, 28-30 aprilie 2010.

VI. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE NEPUBLICATE (E) SAU PUBLICATE DOAR ÎN REZUMAT LA CONFERINȚE ȘI MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

E – Lucrări prezentate în Abstract la diferite conferințe, alte lucrări și contribuții științifice.

E.1 R. Pascu, C. Romanitan, M. Kusko, G. Pristavu, **F. Draghici**, G. Brezeanu, “*Near interface oxide traps investigations using dual sweep C-V characteristics for grown polyoxides on SiC*”, prezentat la International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2019 (ICSCRM 2019), Kyoto, Japonia, 2 Oct. 2019.

E.2 Gheorghe Brezeanu, Gheorghe Pristavu, **Florin Drăghici**, Marian Badila, Razvan Pascu, Ion Rusu, Oana Tutunaru, "High Temperature Measurement Techniques with Ni/SiC Schottky Diodes, Based on Forward Voltage Difference", prezentat la **International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2019 (ICSCRM 2019)**, Kyoto, Japonia, 30 Sept. 2019.

E.3 G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, **F. Drăghici**, M. Badila, "Performances and power efficiency of Ni/4H-SiC Schottky diodes with contact inhomogeneity used for high temperature monitoring", prezentat la **The 2019 Spring Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS Spring 2019)**, Nisa, Franta, 27 Mai 2019.

E.4 R. Pascu, C. Romanitan, M. Kusko, P. Varasteanu, G. Pristavu, **F. Drăghici**, G. Brezeanu, "Using polyoxides as an alternative technological approach to obtain a high quality MOS oxide on SiC", prezentat la **European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM 2018)**, Birmingham, UK, 2018.

E.5 G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, M. Badila, **F. Drăghici**, I. Rusu, "Series Resistance Effect on Inhomogeneous SiC-Schottky Diode Forward Characteristics - An Ideal Interpretation", prezentat la **European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM 2018)**, Birmingham, UK, 2018.

E.6 G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, **F. Drăghici**, M. Badila, "Characterization of non-uniform Ni-4H/SiC Schottky diodes for improved responsivity in high-temperature sensing", prezentat la **E-MRS Fall Meeting and Exhibit**, Varsovia, Polonia, 2018.

E.7 **F. Drăghici**, G. Brezeanu, I. Rusu, E. Popa, "Nanocompozit pe bază de argint pentru contactarea senzorilor de temperaturi înalte pe Carbură de Siliciu (SiC)", **Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie**, ediția a 10-a, 18 mai 2011, Amfiteatrul I.H. Rădulescu, Biblioteca Academiei Române, București, lucrare prezentată la secțiunea poster, http://www.romnet.net/ro/seminar18mai2011/1_poster_f.htm

E.8 G. Brezeanu, **F. Drăghici**, Ion Rusu, "Silicon Carbide (SiC) Devices for Temperature Sensing Applications in Harsh Environments", Universitatea Politehnica București, Facultatea ETTI, prezentare Power Point în cadrul **Colocviilor ETTI**, 25 Noiembrie 2010.

E.9 F. Mitu, C. Boianeanu, **F. Drăghici**, G. Brezeanu, G. Dilimoț, „Automatic Testing System for Power and High Temperature Devices”, in **Workshop on ADVANCED POWER DEVICES**, Romanian Academy, October 1st, 2004.

VII. BREVETE DE INVENȚIE (B) ȘI ALTE TITLURI (A) DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELECTUALĂ

B1. **F. Drăghici**, F. Mitu, "Interfață analogică", **Brevet de invenție, Nr. 122980 / 28.05.2010**, **Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci (OSIM)**, România, Derwent Primary Accession Number: 2010-K27053 [53] în baza ISI, https://ro.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20100528&DB=ro.espacenet.com&locale=ro_RO&CC=RO&NR=122980B1&KC=B1&ND=5.

B2. G. Brezeanu, M. Avram, D. Pușcașu, **F. Drăghici**, I. Rusu, A. Ioncea, "Topografie de diode Schottky pe carbură de siliciu și diamant pentru aplicații de putere și temperatură ridicată", Cerere de Brevet de invenție, Nr. 1007685/16.03.2009, **Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci (OSIM)**, România.

B3. **F. Drăghici** și colectiv, "Aparat cu ultrasunete pentru investigarea lichidelor", Certificat de inovator Nr. 75/14.02.1989, Ministerul Apărării Naționale.

VIII. CONTRACTE CERCETARE

Director/responsabil de proiect, PD

PD.1 PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419, „Senzori și sisteme integrate electronice și fotonice pentru securitatea persoanelor și a infrastructurilor (SENSI)”, Proiectul component P2: „Senzori de hidrocarburi pe SiC pentru securitatea în exploatare în medii industriale ostile, SiC-SENS”, derulare: **2017-2021**, **Responsabil din partea UPB pe proiectul component P2: Florin Drăghici**

PD.2 Parteneriate în domeniile prioritare, Programului 4, direcția de cercetare 1.7.5, GIGASABAR, „Rezonatori de tip SAW și FBAR dedicați aplicațiilor în comunicații pentru gama 2-6GHz și în domeniul senzorilor, obținuți prin tehnici de microprelucrare și nanoprosesare a semiconductorilor de bandă largă GaN și AlN”, derulare: 2007-2010, **Responsabil din partea UPB, Florin Drăghici**, <http://www.imt.ro/gigasabar/>.

Proiecte internaționale ca participant, PI

PI.1 Bilateral cooperation with Foundation for Research & Technology-Hellas (FORTH), Heraklion, Crete, Greece, „Periphery isolation for 4H-SiC high frequency power p-i-n diodes with applications in wireless communications”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici**, derulare: **2003-2005**.

PI.2 Microserv Project, „High Temperature SiC Power Schottky Diode”, Politehnica University of Bucharest, Romania”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici**, derulare: **2000-2002**.

PI.3 Contract DI07 cu Banca Mondială, „Dispozitive circuite și microsisteme electronice”, Director contract UPB: Adrian Rusu, participant: **F. Drăghici**, derulare: **1999-2001**.

PI.4 INCO-Copernicus – Project: 960211/1996, „Lely SiC High Temperature Power Diode Fabrication (PODILESCA)”, (finanțat de U.E.), Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici**, derulare: **1996 – 1998**.

Proiecte Naționale ca participant, PN

PN.1 275-PED/2020, „Senzori PTAT de înaltă temperatură cu diode Schottky pe SiC pentru monitorizare și securitate în medii industriale ostile”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici**, derulare **2020-2022**.

PN.2 PN-III-P2-2.1-PED-2019-4146/ PED 333/2020, „Dispozitiv electrochimic modular pentru stocarea de sarcină”, acronim MSTODE, Responsabil de proiect UPB: Eugeniu Vasile, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici**, derulare **2020-2022**.

PN.3 Programul Operațional Capital Uman (POCU), 2014-2020, Axa Prioritară 6-Educație și competențe, Cod SMIS 125125, Nr. contract: 51675/09.07.2019, „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE), Manager proiect: Prof. Horia IOVU, membru în echipa de implementare - Expert calitate programe doctorale 3, **Florin Drăghici**, derulare **10.07.2019 - 09.01.2021**,

PN.4 Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Cod MySmis: 105976, „NETIO – Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things”, Director de proiect - Adina Magda FLOREA, Responsabil tehnic teme de cercetare - **F. Drăghici**, derulare **2016-2020**.

PN.5 Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2016-0503, contract Nr.180, PED/2017 „Metodă rapidă de analiză bazată pe biosenzor enzimatic pentru determinarea aspartamului din alimente” (ASPSSENS), UPB în parteneriat cu INCDSB (INSB)-coordonator, Responsabil proiect UPB, Conf.dr.ing. RUSU Ion, membru: **F. Drăghici, derulare **2017-2019**.**

PN.6 Parteneriat PN-II-PT-PCCA 2013-4-0297, contract Nr. 146/2016, “Sistem multiparametric pentru monitorizarea fermentării vinului”, UPB în parteneriat cu INCDSB (INSB)-coordonator, Responsabil proiect UPB, Conf. dr. ing. RUSU Ion, membru în echipa de cercetare (persoană cheie): **F. Drăghici, derulare **2014-2016**.**

PN.7 Proiect PN-II-PCCA, 21/2-0479/PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0487, "Senzor inteligent de temperaturi ridicate cu diode pe carbură de siliciu (SiC) pentru aplicații industriale în medii ostile, SiC-SET", Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare (persoană cheie): **F. Drăghici, derulare **2012-2016**.**

PN.8 Proiect PN-II-PCCA Nr. 204/2012, "Detector de gaze inflamabile și toxice bazat pe matrice de senzori MOS pe carbură de siliciu", SiC-GAS, Responsabil de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare (persoană cheie): **F. Drăghici, derulare **2012-2016**.**

PN.9 Proiect postdoctoral, POSDRU/89/1.5/S/63700, cu tema individuală "Senzori de temperatură bazați pe diode Schottky realizate pe Carbură de Siliciu (SiC) pentru aplicații în industria cimentului", finanțator - Autoritatea de Management al Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane AM POSDRU, Funcția - **Florin Drăghici – Responsabil de proiect/Postdoctorand, <http://www.mnt-postdoc.ro/>, derulare **2010 -2013**.**

PN.10 Parteneriat PN2, DIASENZOR – D-11062, “Diode senzor pe Diamant și SiC pentru aplicații speciale în industria cimentului”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici, derulare **2007-2010**, (5 faze).**

PN.11 Grant/ platforma CNCSIS - Platforma Ingineria Integrată a Autovehiculelor – AUTOINTEGRING, coordonator proiect UPB - Catedra de autovehicule rutiere, Director de proiect, Prof. C. Andreeescu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici, derulare **2006-2008**.**

PN.12 Grant CNCSIS, “Fotodiode de mare eficiență pe carbură de siliciu pentru detecția radiațiilor ultraviolete”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici, derulare **2004-2006**, (3 faze).**

PN.13 Contract RELANSIN - 375/24/12/1999, “Dispozitive Schottky pe carbură de siliciu pentru aplicații speciale de putere și temperatură”, Beneficiar: Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic – Politehnica din București, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici, derulare **1999 – 2002**, cinci faze.**

PN.14 Grant ANSTI – 5076 – A63 (15.02.07), “Caracterizarea și testarea dispozitivelor pe SiC pentru aplicații speciale de putere și temperatură”, (continuarea lui A25), Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici, derulare **2002**.**

PN.15 Grant ANSTI – 5076 – A25 (15.01.12), “Caracterizarea și testarea dispozitivelor pe SiC pentru aplicații speciale de putere și temperatură”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici, derulare **2001**.**

PN.16 Grant ANSTI – 5076 – B77 (15.99.16), “Caracterizarea și testarea dispozitivelor pe SiC”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici, derulare **1999**.**

PN.17 Grant ANSTI – 3042 – A16 (15.97.14), “*Fizica interfeței SiO₂ – SiC cu aplicații la tranzistoare MOS și diode Schottky*”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici**, derulare **1997**.

PN.18 Grant MEN – B961 (15.97.11), “*Modelarea procesului de comutație a dispozitivelor semiconductoare*”, Director de proiect UPB: Gheorghe Brezeanu, membru în echipa de cercetare: **F. Drăghici**, derulare **1997**.

15 Octombrie, 2021

Conf. Dr. Ing. Florin Drăghici